



光子学报 » 2013, Vol. 42 » Issue (7): 757-762 DOI: 10.3788/gzxb20134207.0757

[光电子学与光电子器件](#)[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)[后一篇](#) >>

GaN垒层厚度渐变的双蓝光波长发光二极管

李正凯, 严启荣, 罗长得, 肖汉章, 章勇

华南师范大学 光电子材料与技术研究所, 广州 510631

Dual-blue Wavelength Light-emitting Diodes Based on Varied GaN Barrier Thickness

LI Zheng-kai, YAN Qi-rong, LUO Chang-de, XIAO Han-zhang, ZHANG Yong

Institute of Optoelectronic Materials and Technology, South China Normal University, Guangzhou 510631, China

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(20\)](#)[相关文章\(14\)](#)